




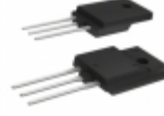




	<p>Hersteller-Teilenummer: IPA65R099C6XKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 38A TO220</p>
	<p>Datenblätter:  IPA65R099C6XKSA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPA65R099C6XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 38A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 1.2mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220 Full Pack
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	99 mOhm @ 12.8A, 10V
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2780pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	127nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38A (Tc)

IPA65R099C6XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPA65R099C6XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPA65R099C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPA65R099C6XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPA65R125C7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V TO220-3</p>	 <p>IPA65R045C7 INFINEON IPA65R045C7 INFINEON</p>	 <p>IPA65R065C7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V TO220-3</p>	 <p>IPA65R045C7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V TO220-3</p>
 <p>IPA65R065C7 inf IPA65R065C7 inf</p>	 <p>IPA65R110CFD INFINEON IPA65R110CFD INFINEON</p>	 <p>IPA65R110CFDXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 31.2A TO220</p>	 <p>IPA65R095C7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V TO220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPA65R099C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPA65R099C6XKSA1 Datenblatt	IPA65R099C6XKSA1-Datenblätter	IPA65R099C6XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPA65R099C6XKSA1
IPA65R099C6XKSA1 Electronic	IPA65R099C6XKSA1-Komponenten	IPA65R099C6XKSA1-Verteiler	IPA65R099C6XKSA1-Bild	IPA65R099C6XKSA1-Teil
IPA65R099C6XKSA1 Preis	IPA65R099C6XKSA1 Hersteller	IPA65R099C6XKSA1 Bild	IPA65R099C6XKSA1 Aktie	IPA65R099C6XKSA1 Inventar
IPA65R099C6XKSA1 Neu	IPA65R099C6XKSA1 Original	IPA65R099C6XKSA1 garantiert	IPA65R099C6XKSA1 RFQ	IPA65R099C6XKSA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited